

#10  
Attorney Docket: 3007/49966  
PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: AKIHIRO ISHII ET AL.

Serial No.: 09/853,085                  Group Art Unit:

Filed: MAY 11, 2001                  Examiner:

Title: PROCESS FOR PRODUCING OPTICALLY ACTIVE 1-(FLUORO-  
OR TRIFLUOROMETHYL-SUBSTITUTED PHENYL) ETHYLAMINE AND PROCESS  
FOR PURIFYING SAME

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119

Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing dates of prior foreign application Numbers,

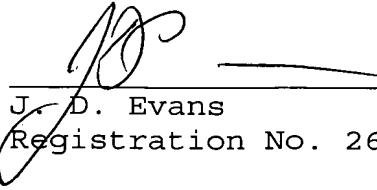
1. 2000-138349 filed in Japan on May 11, 2000.
2. 2000-142460 filed in Japan on May 15, 2000.
3. 2000-185405 filed in Japan on June 20, 2000.
4. 2000-369007 filed in Japan on December 4, 2000.
5. 2000-387724 filed in Japan on December 20, 2000.
6. 2001-054716 filed in Japan on February 28, 2001.
7. 2001-109735 filed in Japan on April 9, 2001.

are hereby requested and the right of priority under 35 U.S.C. §119 is hereby claimed.

In support of this claim, filed herewith are certified copies of the foreign applications.

Respectfully submitted,

December 11, 2001

  
J. D. Evans  
Registration No. 26,269

CROWELL & MORING, LLP  
P.O. Box 14300  
Washington, DC 20044-4300  
Telephone No.: (202) 624-2500  
Facsimile No.: (202) 628-5116

P01CG-0050S(1)



日本特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 5月11日

出願番号

Application Number:

特願2000-138349

出願人

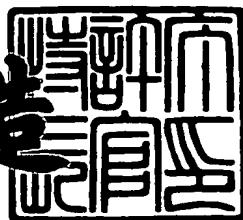
Applicant(s):

セントラル硝子株式会社

2001年 5月25日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3043313

【書類名】 特許願  
 【整理番号】 00K1016  
 【提出日】 平成12年 5月11日  
 【あて先】 特許庁長官殿  
 【国際特許分類】 C07C211/27  
 C07B 53/00

## 【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラル硝子  
 株式会社化学研究所内

【氏名】 石井 章央

## 【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラル硝子株  
 式会社化学研究所内

【氏名】 栗山 克

## 【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラル硝子株  
 式会社化学研究所内

【氏名】 金井 正富

## 【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラル硝子  
 株式会社化学研究所内

【氏名】 速水 崇

## 【特許出願人】

【識別番号】 000002200

【氏名又は名称】 セントラル硝子株式会社

## 【代理人】

【識別番号】 100108671

【弁理士】

【氏名又は名称】 西 義之

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013837

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

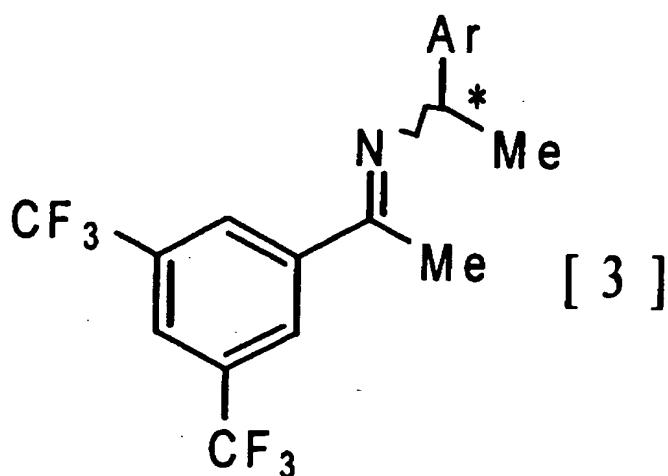
【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学活性  $\alpha$ -メチルビス-3, 5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンの製造方法

【特許請求の範囲】

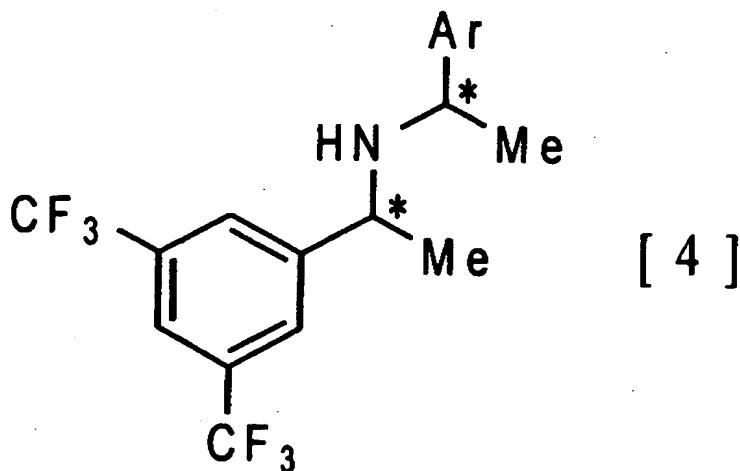
【請求項1】 一般式 [3]

【化1】



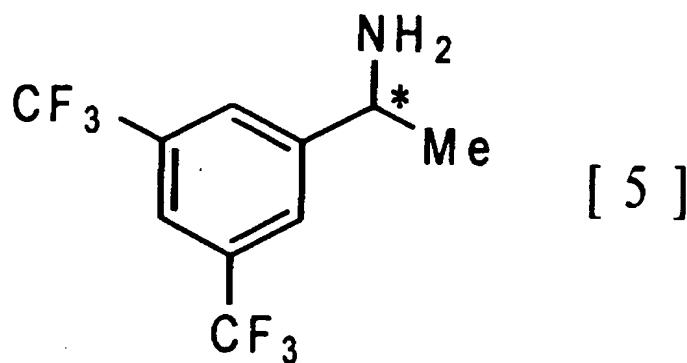
[式中、Arは、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は、不斉炭素を表す]で示される光学活性イミンを不斉還元することにより、一般式 [4]

【化2】



[式中、Arは、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は、不斉炭素を表す]で示される光学活性二級アミンに変換し、該二級アミンを加水素分解することにより、式[5]

【化3】

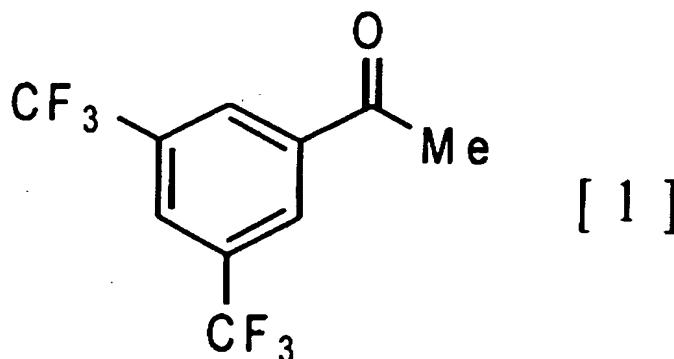


[式中、\*は、不斉炭素を表す]で示される光学活性α-メチルビス-3,

5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンを製造する方法。

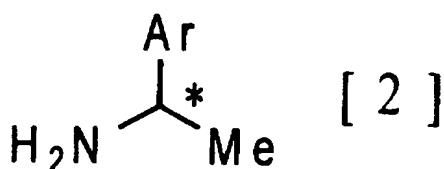
【請求項2】 請求項1に記載した一般式〔3〕で示される光学活性イミンが  
、式〔1〕

【化4】



で示されるビス-3, 5-(トリフルオロメチル)フェニルメチルケトンと、一  
般式〔2〕

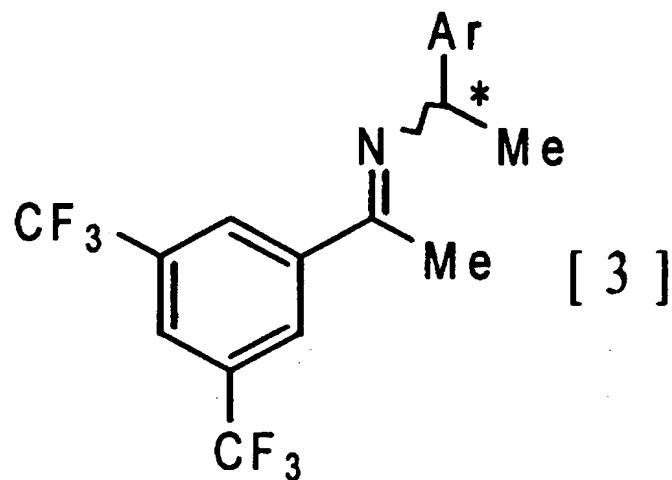
【化5】



[式中、 $\text{Ar}$ は、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は  
、不斉炭素を表す] で示される光学活性一級アミンを酸性条件下、脱水縮合する  
ことによって得られる光学活性イミンである請求項1に記載した製造方法。

【請求項3】 一般式〔3〕

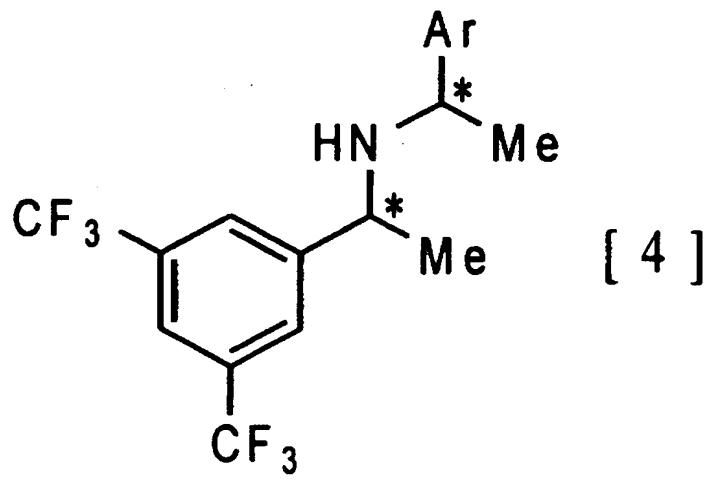
【化6】



[式中、Arは、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は、不斉炭素を表す]で示される光学活性イミン。

【請求項4】 一般式 [4]

【化7】



[式中、Arは、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は、不斉炭素を表す]で示される光学活性二級アミン。

【請求項5】一般式[3]、[4]、[2]、または、式[5]で示される化合物の立体化学が、R体（またはS体）である請求項1、または、2に記載した製造方法。

【請求項6】一般式[3]、または、[4]で示される化合物の立体化学が、R体（またはS体）である請求項3、または、4に記載した化合物。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

##### 【発明の属する技術分野】

本発明は、医薬および農薬の重要な中間体である光学活性 $\alpha$ -メチルビス-3,5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンの製造方法に関する。

##### 【0002】

##### 【従来の技術】

光学活性 $\alpha$ -メチルビス-3,5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンは、医薬および農薬の重要な中間体である。該光学活性アミンの製造方法に関しては、J. Am. Chem. Soc., 112, 5741(1990)に1件報告されているのみで、J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2039(1985)記載のオキシム誘導体の不斉還元を参考にして合成している。しかしながら、その化学収率および光学純度は、それぞれ、15%、71%ee(S)と低く、該光学活性アミンの工業的に簡便で且つ効率の良い製造方法ではなかった。

##### 【0003】

また、本発明の技術的背景として、光学活性N-(アルキルベンジリデン)- $\alpha$ -メチルベンジルアミンの不斉還元がある。このタイプのジアステレオ選択性な1,3-不斉還元の研究は多く行われているが、得られる生成物が下記一般式[6]に示すような窒素原子に対して二つの同様な $\alpha$ -アルキルベンジル基を持つことになり、一般的なキラル補助基の除去方法である加水分解では、キラル

補助基側（b）だけを選択的に切断することができず、これらの一連の技術は一般的な光学活性 $\alpha$ -アルキルベンジルアミンの不斉合成法としては採用され難かった。

## 【0004】

## 【発明が解決しようとする課題】

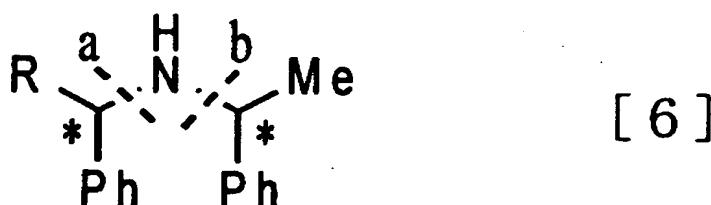
上記の1, 3-不斉還元において、特に、本発明で対象とする一般式〔4〕で示される還元生成物の場合、アルキル基が共にメチル基であるため、切断箇所における立体的な嵩高さはほとんど同じである。このような場合には、アリール基上の置換基の電子的な効果を利用して選択的に切断するしかない。

## 【0005】

しかしながら、このような研究は非常に限られており、特に、本発明で対象とするトリフルオロメチル基が2つ置換した下記一般式〔7〕で示される化合物の選択的な加水素分解については全く報告されていない。また、不斉還元で優先的に得られる相対配置においてもキラル補助基側（b）で選択的に切断できるかについては全く不明であった。

## 【0006】

## 【化8】

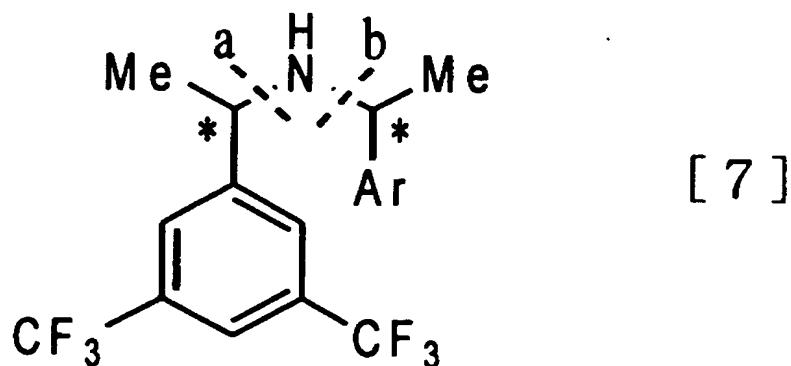


## 【0007】

[式中、Rは、アルキル基を表し、\*は、不斉炭素を表す]

## 【0008】

【化9】



【0009】

[式中、Arは、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は、不斉炭素を表す]

【0010】

## 【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記の課題を解決すべく銳意検討を行った結果、ビス-3, 5-（トリフルオロメチル）フェニルメチルケトンと光学活性一級アミンを酸性条件下、脱水縮合することによって得られる光学活性イミンを不斉還元することにより、光学活性二級アミンに変換し、該二級アミンを加水分解することにより、光学活性 $\alpha$ -メチル-ビス-3, 5-（トリフルオロメチル）ベンジルアミンが高い不斉純度で収率良く製造できることを見出した。

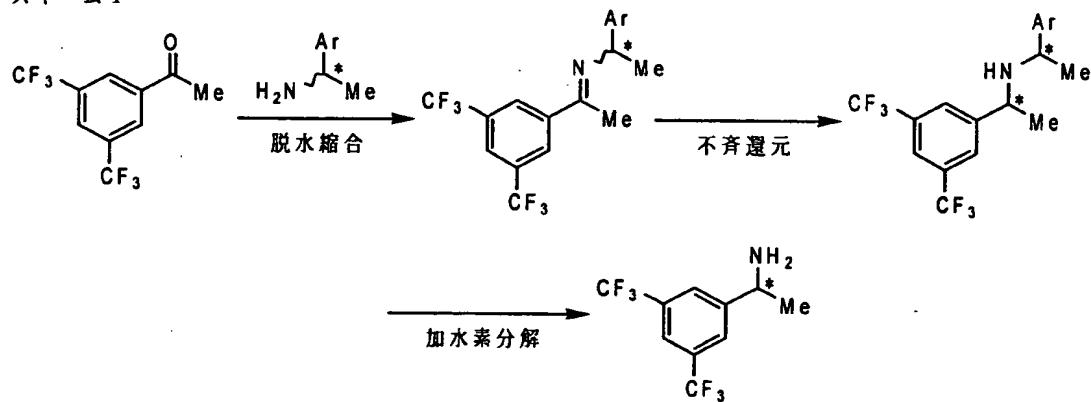
【0011】

本発明の方法は、次のスキーム1で表される。

【0012】

## 【化10】

スキーム1



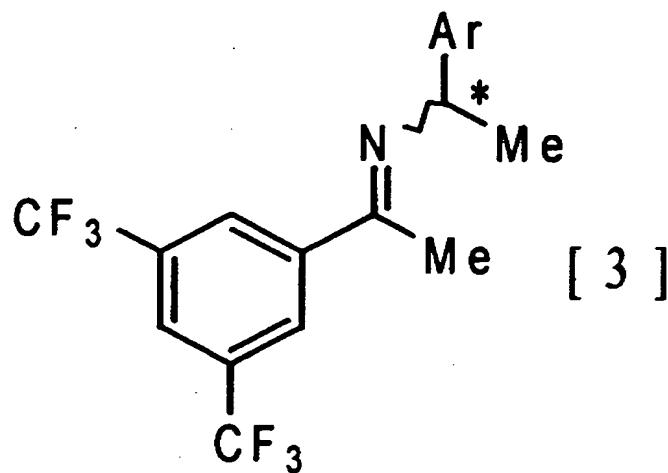
## 【0013】

すなわち、本発明は、

(1) 一般式 [3]

【0014】

## 【化11】



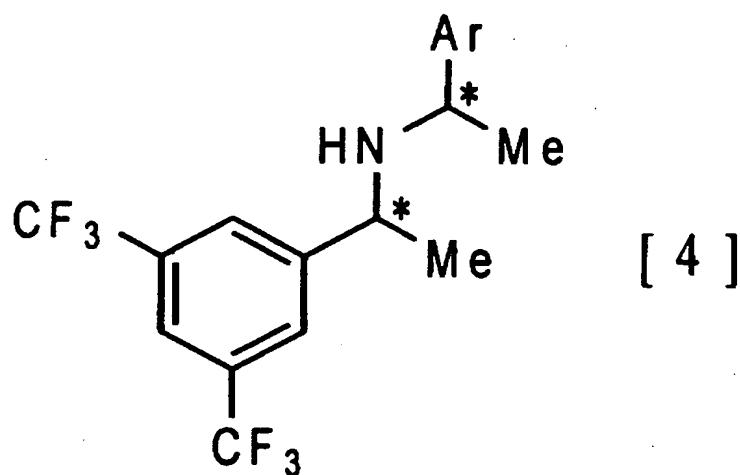
## 【0015】

[式中、Arは、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は

、不斉炭素を表す]で示される光学活性イミンを不斉還元することにより、一般式 [4]

【0016】

【化12】

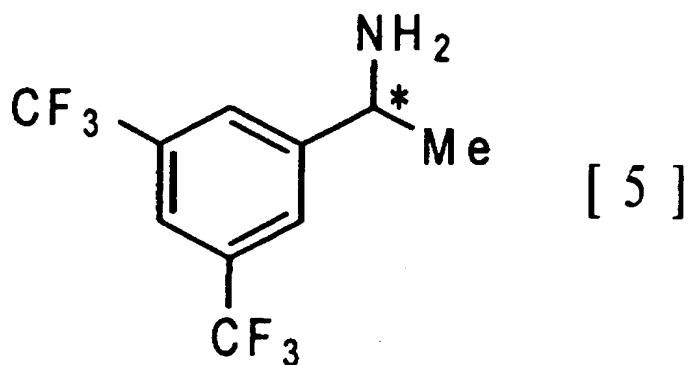


【0017】

[式中、Arは、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は、不斉炭素を表す]で示される光学活性二級アミンに変換し、該二級アミンを加水素分解することにより、式 [5]

【0018】

【化13】



【0019】

[式中、\*は、不斉炭素を表す]で示される光学活性 $\alpha$ -メチルビス-3,5-（トリフルオロメチル）ベンジルアミンを製造する方法である。

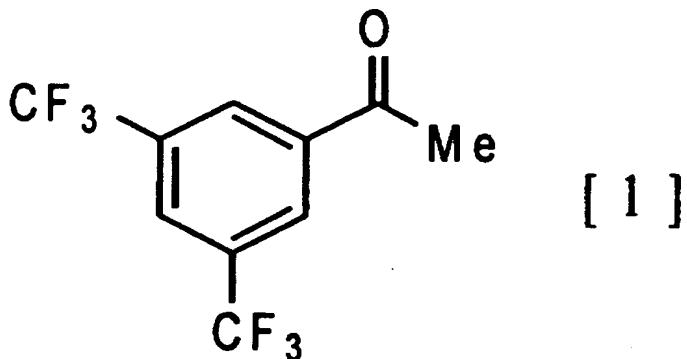
【0020】

また、本発明は、

(2) 一般式【3】で示される光学活性イミンが、式【1】

【0021】

【化14】

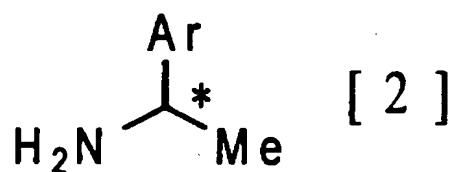


【0022】

で示されるビス-3, 5-(トリフルオロメチル) フェニルメチルケトンと、一般式 [2]

【0023】

【化15】



【0024】

[式中、Arは、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は、不斉炭素を表す] で示される光学活性一級アミンを酸性条件下、脱水縮合することによって得られる光学活性イミンである上記の製造方法である。

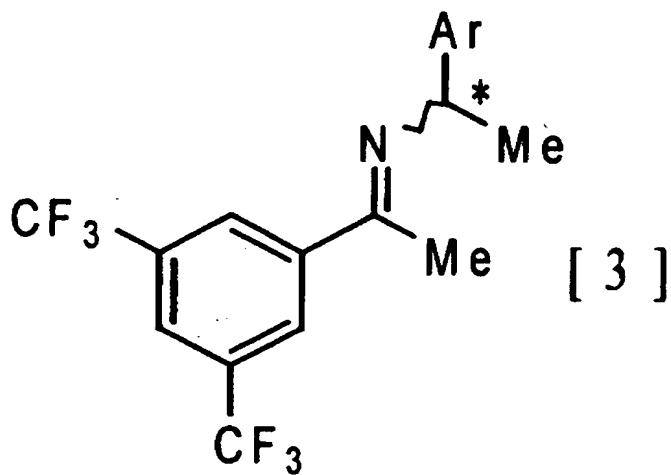
【0025】

また、本発明は、

(3) 一般式 [3]

【0026】

【化16】



【0027】

[式中、Arは、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は、不斉炭素を表す]で示される光学活性イミンである。

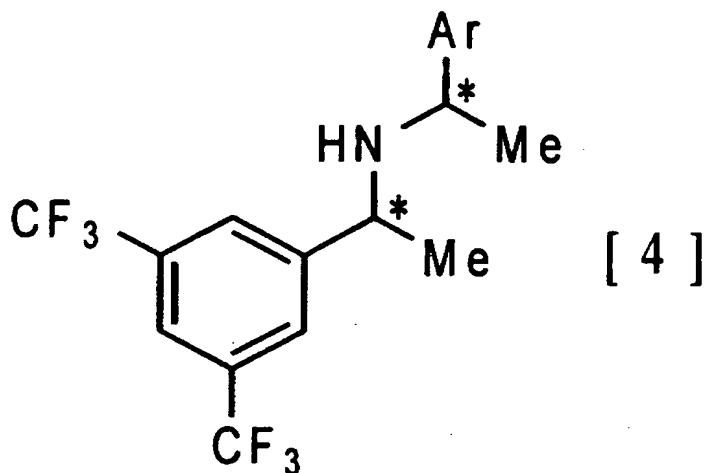
【0028】

また、本発明は、

(4) 一般式 [4]

【0029】

【化17】



【0030】

[式中、Arは、フェニル基、または、1もしくは2-ナフチル基を表し、\*は、不斉炭素を表す]で示される光学活性二級アミンである。

【0031】

また、本発明は、

(5) 一般式〔3〕、〔4〕、〔2〕、または、式〔5〕で示される化合物の立体化学が、R体（またはS体）である（1）、または、（2）に記載した製造方法である。

【0032】

また、本発明は、

(6) 一般式〔3〕、または、〔4〕で示される化合物の立体化学が、R体（またはS体）である（3）、または、（4）に記載した化合物である。

【0033】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の光学活性 $\alpha$ -メチル-ビス-3, 5-(トリフルオロメチル)

ベンジルアミンの製造方法について詳細に説明する。

【0034】

本発明の製造方法は、ビス-3, 5-(トリフルオロメチル)フェニルメチルケトンと光学活性一級アミンを酸性条件下、脱水縮合することにより光学活性イミンを製造する過程（第一過程）、該光学活性イミンを不斉還元することにより光学活性二級アミンを製造する過程（第二過程）および該光学活性二級アミンを加水素分解することにより光学活性 $\alpha$ -メチルービス-3, 5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンを製造する過程（第三過程）の三つよりなる。

【0035】

本発明の第一過程において、一般式〔3〕で示される光学活性イミンを以下の方法により工業的に簡便で且つ効率良く製造することができる。

【0036】

すなわち、式〔1〕で示されるビス-3, 5-(トリフルオロメチル)フェニルメチルケトンと一般式〔2〕で示される光学活性一級アミンを酸性条件下、脱水縮合することにより製造することができる。

【0037】

一般式〔2〕で示される光学活性一級アミンとしては、1-フェニルエチルアミン、1-1' -ナフチルエチルアミン、1-2' -ナフチルエチルアミン等が挙げられる。その中でも、1-フェニルエチルアミンおよび1-2' -ナフチルエチルアミンが好ましく、特に、1-フェニルエチルアミンがより好ましい。また、該光学活性一級アミンにはR体またはS体が存在するため、それから誘導される一般式〔3〕で示される光学活性イミンにもR体またはS体が存在するが、これらの鏡像体は目的とする生成物の絶対配置に応じて適宜使い分ければよい。

【0038】

一般式〔2〕で示される光学活性一級アミンの使用量は、通常は式〔1〕で示されるビス-3, 5-(トリフルオロメチル)フェニルメチルケトンに対して、1モル当量以上使用すればよく、1~10モル当量が好ましく、特に、1~5モル当量がより好ましい。

【0039】

本反応は、式〔1〕で示されるケトンと一般式〔2〕で示される光学活性一级アミンの脱水縮合であるため、酸性条件下、副生する水を除きながら反応を行う。好ましくは、水と混和せず、水よりも比重が小さく、水と共に沸する溶媒を用いて、還流条件下、ディーン・スターク管で副生する水を除く。

## 【0040】

使用される溶媒としては、水と共に沸する溶媒であればよく、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンおよびメシチレン等の芳香族炭化水素系が好ましく、特に、トルエンがより好ましい。これらの溶媒は、単独または組み合わせて用いることができる。

## 【0041】

溶媒の使用量としては、理論的に副生する水の量を共沸除去できるだけの溶媒量を必要とするが、ディーン・スターク管を用いることにより使用量を極端に減らすことができる。

## 【0042】

本脱水縮合において使用される酸触媒としては、p-トルエンスルホン酸、10-カンファースルホン酸等の有機酸、塩酸、硫酸、リン酸等の無機酸が挙げられる。その中でも、p-トルエンスルホン酸および硫酸が好ましく、特に、p-トルエンスルホン酸がより好ましい。

## 【0043】

酸触媒の使用量としては、式〔1〕で示されるケトンに対して、触媒量使用すればよく、0.001~1モル当量が好ましく、特に、0.005~0.5モル当量がより好ましい。

## 【0044】

本脱水縮合の温度条件は、使用する溶媒と水の共沸温度から溶媒の沸点までの範囲で行なうことができ、特に、使用する溶媒の沸点付近がより好ましい。

## 【0045】

本発明の第一過程の後処理においては、反応終了後、通常の後処理操作を行うことによって、粗生成物を得ることができる。粗生成物は、必要に応じて、活性炭、蒸留、再結晶、カラムクロマトグラフィー等の精製操作を行い、目的の一般

式〔3〕で示される光学活性イミンを高い純度で得ることができる。また、単離精製せずに第二過程の不斉還元に用いることができる。具体的には、反応終了液をそのまま、または、反応終了液を炭酸水素ナトリウムまたは水酸化ナトリウム等のアルカリ水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムまたは無水硫酸ナトリウム等の乾燥剤で乾燥し、濾過して得られる該光学活性イミンのトルエン溶液等を用いることができる。

## 【0046】

また、本発明の第二過程において、一般式〔4〕で示される光学活性二級アミンを以下の方法により工業的に簡便で且つ効率良く製造することができる。

## 【0047】

すなわち、第一過程で製造した一般式〔3〕で示される光学活性イミンを遷移金属錯体を用いる接触還元（第二過程①法）またはハイドライド還元（第二過程②法）することにより製造することができる。

## 【0048】

初めに、遷移金属錯体を用いる接触還元（第二過程①法）について詳細に説明する。

## 【0049】

遷移金属錯体としては、酸化白金、白金／活性炭、白金黒等の白金触媒、還元ニッケル、ラネーニッケル、白金付きラネーニッケル等のニッケル触媒、ラネーコバルト等のコバルト触媒、還元銅、銅－クロム酸化物等の銅触媒、亜鉛－クロム酸化物等の亜鉛触媒、酸化ルテニウム、ルテニウム／活性炭等のルテニウム触媒、ロジウム／活性炭、ロジウム／アルミナ、ロジウム－酸化白金等のロジウム触媒、イリジウム黒等のイリジウム触媒、酸化レニウム等のレニウム触媒、パラジウム／活性炭、パラジウム黒、パラジウム／硫酸バリウム、パラジウム／炭酸ストロンチウム、パラジウム／炭酸カルシウム、パラジウム／炭酸カルシウム－二酢酸鉛、パラジウム／硫酸バリウム－キノリン、パラジウム／アルミナ、パラジウムスponジ、塩化パラジウム、酢酸パラジウム、パラジウムアセチルアセトナート、ビス（ジベンジリデンアセトン）パラジウム、テトラキス（トリフェニルホスфин）パラジウム、ジクロロ〔ビス（トリフェニルホスфин）〕パラ

ジウム、ジクロロ [ビス (ジフェニルホスフィノ) メタン] パラジウム、ジクロロ [ビス (ジフェニルホスフィノ) エタン] パラジウム、ジクロロ [1, 3-ビス (ジフェニルホスフィノ) プロパン] パラジウム、ジクロロ [1, 4-ビス (ジフェニルホスフィノ) ブタン] パラジウム、ジクロロ (1, 5-シクロオクタジエン) パラジウム、ジクロロ [ビス (ベンゾニトリル)] パラジウム、ジクロロ [ビス (アセトニトリル)] パラジウム、酢酸 [ビス (トリフェニルホスフィン)] パラジウム等のパラジウム触媒等が挙げられる。その中でも、白金触媒、ロジウム触媒およびパラジウム触媒が好ましく、特に、白金／活性炭、ロジウム／活性炭およびパラジウム／活性炭がより好ましい。

## 【0050】

これらの触媒は、単独または組み合わせて用いることができる。金属を担体に担持させた触媒を用いる場合、その担持量は、0. 1～50重量%であり、0. 5～30重量%が好ましく、特に、1～20重量%がより好ましい。また、取り扱いの安全性を高めるために、または、金属表面の酸化を防ぐために、水、鉛油等にからませたものを使うこともできる。

## 【0051】

遷移金属錯体の触媒量は、通常は一般式 [3] で示される光学活性イミンに対して、0. 01～50重量%であり、0. 5～30重量%が好ましく、特に、1～20重量%がより好ましい。

## 【0052】

接触還元の水素の量は、通常は一般式 [3] で示される光学活性イミンに対して、1モル当量以上使用すればよいが、通常は反応系を水素雰囲気下で行うため大過剰使用する。

## 【0053】

接触還元の水素圧は、0. 01～10 MPa であり、0. 05～5 MPa が好ましく、特に、0. 1～2 MPa がより好ましい。

接触還元の水素源は、分子状水素以外に、ギ酸、ギ酸アンモニウム、ヒドラジン等を用いることができる。

## 【0054】

接触還元で使用される溶媒としては、n-ペンタン、n-ヘキサン、c-ヘキサン、n-ヘプタン等の脂肪族炭化水素系、ベンゼン、トルエン、キシレン、メシチレン等の芳香族炭化水素系、塩化メチレン、クロロホルム、1、2-ジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素系、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、t-ブチルメチルエーテル、ジオキサン等のエーテル系、酢酸エチル、酢酸n-ブチル等のエステル系、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール等のアルコール系、酢酸、プロピオン酸、酪酸等のカルボン酸系、塩酸、硫酸、臭化水素酸、p-トルエンスルホン酸、10-カンファースルホン酸等の酸性水溶液、水等が挙げられる。その中でも、トルエン、酢酸エチル、メタノール、エタノール、i-プロパノール、酢酸、塩酸水溶液が好ましく、特に、メタノール、エタノール、i-プロパノール、塩酸水溶液がより好ましい。これらの溶媒は単独または組み合わせて用いることができる。

## 【0055】

接触還元の温度範囲は、-50~150°Cであり、-25~100°Cが好ましく、特に、0~80°Cがより好ましい。

## 【0056】

次に、ハイドライド還元剤による不斉還元（第二過程②法）について詳細に説明する。

## 【0057】

ハイドライド還元剤としては、(i-Bu)<sub>2</sub>AlH、(i-Bu)<sub>3</sub>Al、[2、6-(t-Bu)<sub>2</sub>-4-Me]Al(i-Bu)<sub>2</sub>、LiAlH<sub>4</sub>、LiAlH(OMe)<sub>3</sub>、LiAlH(O-t-Bu)<sub>3</sub>、NaAlH<sub>2</sub>(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>等のアルミニウムハイドライド系、ジボラン、BH<sub>3</sub>·THF、BH<sub>3</sub>·SMe<sub>2</sub>、BH<sub>3</sub>·NMe<sub>3</sub>、9-BBN、NaBH<sub>4</sub>、NaBH<sub>4</sub>-CeCl<sub>3</sub>、LiBH<sub>4</sub>、Zn(BH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>、Ca(BH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>、Lin-BuBH<sub>3</sub>、NaBH(OMe)<sub>3</sub>、NaBH(OAc)<sub>3</sub>、NaBH<sub>3</sub>CN、Et<sub>4</sub>NBH<sub>4</sub>、Me<sub>4</sub>NBH(OAc)<sub>3</sub>、(n-Bu)<sub>4</sub>NBH<sub>3</sub>CN、(n-Bu)<sub>4</sub>NBH(OAc)<sub>3</sub>、Li(s-Bu)<sub>3</sub>BH、K(s-Bu)<sub>3</sub>BH、LiSi<sub>2</sub><sub>3</sub>BH、KSi<sub>2</sub><sub>3</sub>BH、LiEt<sub>3</sub>BH、KPh<sub>3</sub>BH、(Ph<sub>3</sub>P)<sub>2</sub>CuBH<sub>4</sub>、ThxBH<sub>2</sub>、Si

$\text{Al}_2\text{BH}$ 、カテコールボラン、 $\text{IpcBH}_2$ 、 $\text{Ipc}_2\text{BH}$ 等のホウ素ハイドライド系、 $\text{Et}_3\text{SiH}$ 、 $\text{PhMe}_2\text{SiH}$ 、 $\text{Ph}_2\text{SiH}_2$ 、 $\text{PhSiH}_3-\text{Mo}(\text{CO})_6$ 等のケイ素ハイドライド系等が挙げられる。その中でも、 $\text{LiAlH}_4$ 、ジボラン、 $\text{NaBH}_4$ および $\text{LiBH}_4$ が好ましく、特に、 $\text{LiAlH}_4$ および $\text{NaBH}_4$ がより好ましい。これらのハイドライド還元剤は、各種無機塩の存在下、行うこともできる。

## 【0058】

ハイドライド還元剤の使用量は、通常は一般式 [3] で示される光学活性イミンに対して、1モル当量以上使用すればよく、1~10モル当量が好ましく、特に、1~7モル当量がより好ましい。

## 【0059】

ハイドライド還元で使用される溶媒としては、n-ペンタン、n-ヘキサン、c-ヘキサン、n-ヘプタン等の脂肪族炭化水素系、ベンゼン、トルエン、キシレン、メシチレン等の芳香族炭化水素系、塩化メチレン、クロロホルム、1、2-ジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素系、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、t-ブチルメチルエーテル、ジオキサン等のエーテル系、酢酸エチル、酢酸n-ブチル等のエステル系、アセトニトリル、プロピオニトリル等のニトリル系、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール等のアルコール系、酢酸、プロピオン酸、酪酸等のカルボン酸系等が挙げられる。その中でも、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、t-ブチルメチルエーテル、メタノール、エタノール、i-プロパノールが好ましく、特に、テトラヒドロフラン、メタノール、エタノール、i-プロパノールがより好ましい。これらの溶媒は、単独または組み合わせて用いることができる。

## 【0060】

ハイドライド還元の温度範囲は、-100~100°Cであり、-80~80°Cが好ましく、特に、-60~60°Cがより好ましい。

## 【0061】

本発明の第二過程の後処理においては反応終了後、通常の後処理操作を行うことにより、粗生成物を得ることができる。得られた粗生成物は、必要に応じて、

活性炭、蒸留、再結晶、カラムクロマトグラフィー等の精製操作を行うことにより、目的の一般式〔4〕で示される光学活性二級アミンを高い純度で得ることができる。

## 【0062】

また、本発明の第三過程において、一般式〔5〕で示される光学活性 $\alpha$ -メチルービス-3, 5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンを以下の方法により工業的に簡便で且つ効率良く製造することができる。

## 【0063】

すなわち、第二過程で製造した一般式〔4〕で示される光学活性二級アミンを加水素分解することにより製造することができる。

## 【0064】

加水素分解の反応条件は、第二過程の遷移金属錯体を用いる接触還元の反応条件と基本的に同じであるが、加水素分解は不斉還元よりも厳しい反応条件を必要とする。従って、緩和な反応条件を選択することにより不斉還元だけを進行させ、反応終了液を取り出さずに、同じ耐圧反応容器内で引き続き加水素分解を行うこともできる。その際、遷移金属錯体を追加したり、水素圧または反応温度を上げることにより加水素分解を効率的に行うことができる。

## 【0065】

本発明の第三過程の後処理においては、反応終了後、通常の後処理操作を行うことにより、粗生成物を得ることができる。得られた粗生成物は、必要に応じて、活性炭、蒸留、再結晶、カラムクロマトグラフィー等の精製操作を行うことにより、目的の式〔5〕で示される光学活性 $\alpha$ -メチルービス-3, 5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンを高い純度で得ることができる。

## 【0066】

## 【実施例】

以下、実施例により、本発明の実施の形態を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

## 【0067】

実施例に示した $\alpha$ -メチルービス-3, 5-(トリフルオロメチル)ベンジル

アミンの絶対配置は、旋光度の実測値の符号と文献値を比較して決定した。また、それぞれの変換率、ジアステレオマー比および光学純度は、キラルG C (C P -Chirasil-Dex CB) により決定した。

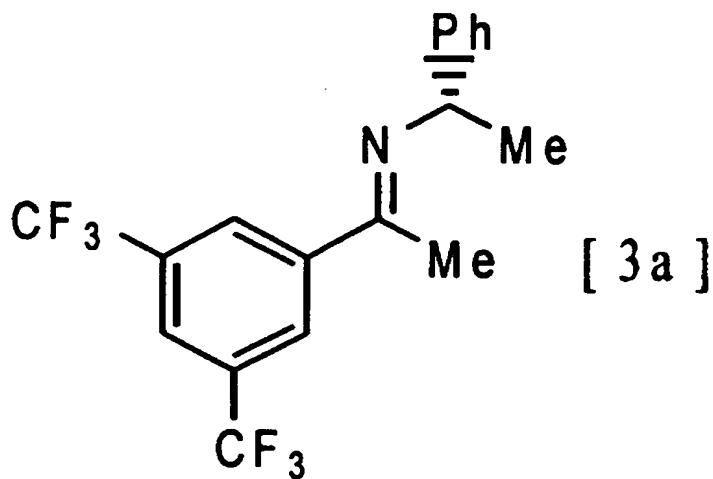
## 【0068】

## [実施例1]

トルエン100mlに、ビス-3, 5-(トリフルオロメチル)フェニルメチルケトン 10g (39.06mmol, 1eq)、(S)-1-フェニルエチルアミン 4.96g (41.02mmol, 1.05eq) とp-トルエンスルホン酸・一水和物 0.37g (1.95mmol, 0.05eq) を溶解し、24時間加熱還流し、副生する水をディーン・スターク管で除いた。反応終了液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濾過、濃縮、真空乾燥し、下記式

## 【0069】

## 【化18】



## 【0070】

で示される光学活性イミン (3a) の粗生成物を定量的に得た。粗生成物はさら

に精製を行わず不斉還元に用いた。

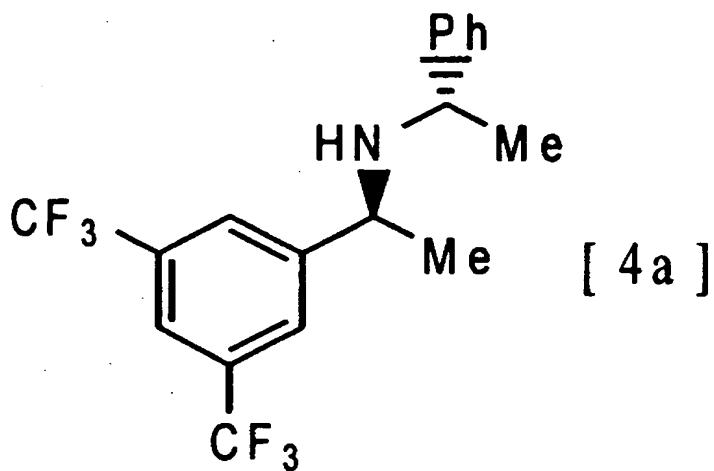
<sup>1</sup>H-NMR (TMS, CDCl<sub>3</sub>) : 1. 55 (d, 6. 4 Hz, 3 H)、2. 33 (s, 3 H)、4. 87 (q, 6. 4 Hz, 1 H)、7. 24 (t, 7. 8 Hz, 1 H)、7. 35 (t, 7. 8 Hz, 2 H)、7. 45 (d, 7. 8 Hz, 2 H)、8. 31 (s, 1 H)、8. 38 (s, 2 H).

### [実施例2]

エタノール2mlに、実施例1で製造した光学活性イミン(3a) 359mg (1mmol)と5%パラジウム／活性炭(50重量%含水) 7mg (2重量%)を加え、水素圧を0.2MPaに設定し、室温で12時間攪拌した。反応終了液をセライト濾過、濃縮、真空乾燥し、下記式

【0071】

### 【化19】



【0072】

で示される光学活性二級アミン(4a)の粗生成物を得た。粗生成物の変換率とジアステレオマー比はキラルGCにより決定し、それぞれ100%、SS:SR

= 1. 9 : 1 であった。

<sup>1</sup>H-NMR (TMS, CDCl<sub>3</sub>) : 1. 28 (d, 6. 5 Hz, 3 H)、1. 29 (d, 6. 4 Hz, 3 H)、1. 58 (br, 1 H)、3. 39 (q, 6. 5 Hz, 1 H)、3. 65 (q, 6. 4 Hz, 1 H)、7. 05-7. 44 (m, 5 H)、7. 70 (s, 2 H)、7. 76 (s, 1 H)。

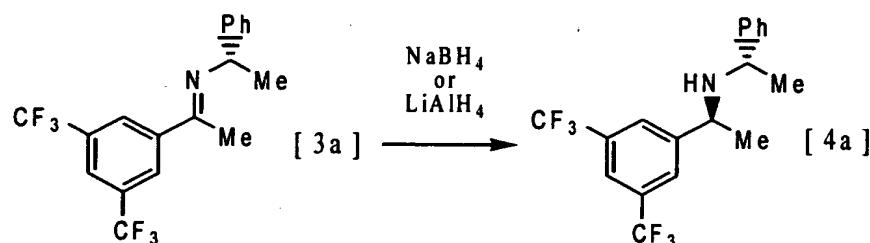
### [実施例3-9]

#### (代表的な実験操作)

各種アルコール 5 mL に、実施例1で製造した光学活性イミン (3a) 35 mg (1 mmol, 1 eq) を溶解し、設定温度に冷却後、水素化ホウ素ナトリウム 38 mg または水素化リチウムアルミニウム 38 mg (1 mmol, 4 eq) を加え、所定時間攪拌した。反応終了液に、0. 1 N 塩酸を加えて反応を終了させ、酢酸エチルで抽出、0. 5 N 水酸化ナトリウムで洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濾過、濃縮、真空乾燥し、実施例2と同じ光学活性二級アミン (4a) の粗生成物を得た。粗生成物の変換率とジアステレオマー比はキラルGCにより決定した。各実施例の反応条件と結果を表1にまとめた。

### 【0073】

#### 【化20】



### 【0074】

【表1】

| 実施例 | 反応溶媒      | ハイドライド<br>還元剤     | 反応温度<br>(℃) | 反応時間<br>(h) | 変換率<br>(%) | ジアステロマー-比<br>(SS : SR) |
|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| 3   | メタノール     | NaBH <sub>4</sub> | 0           | 2           | 100        | 5.4 : 1                |
| 4   | i-ブローパノール | NaBH <sub>4</sub> | 0           | 3           | 100        | 7.2 : 1                |
| 5   | i-ブローパノール | NaBH <sub>4</sub> | -40         | 1           | 91         | 6.6 : 1                |
| 6   | エタノール     | NaBH <sub>4</sub> | 室温          | 20          | 100        | 5.7 : 1                |
| 7   | エタノール     | NaBH <sub>4</sub> | -10         | 2           | 100        | 6.9 : 1                |
| 8   | エタノール     | NaBH <sub>4</sub> | -40         | 4           | 100        | 7.8 : 1                |
| 9   | テトラヒドロフラン | Al                | 室温          | 14          | 47         | 2.1 : 1                |

## 【0075】

## 【実施例10】

エタノール2m1に、実施例8で製造した光学活性二級アミン(4a)の粗生成物181mg(0.5mmol)と5%パラジウム/活性炭(50重量%含水)18mg(10重量%)を加え、水素圧を0.2MPaに設定し、55℃で12時間攪拌した。反応終了液をセライト濾過、濃縮、真空乾燥し、(S)- $\alpha$ -メチルビス-3,5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンの粗生成物96mgを得た。収率は75%であった。粗生成物の光学純度はキラルGCにより決定し、76%eeであった。

## 【0076】

## 【発明の効果】

医薬および農薬の重要な中間体である光学活性 $\alpha$ -メチルビス-3,5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンを工業的に簡便で且つ効率良く製造できる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

医薬および農薬の重要な中間体である光学活性  $\alpha$ -メチルビス-3,5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンを製造する方法を提供する。

【解決の手段】

ビス-3,5-(トリフルオロメチル)フェニルメチルケトンと光学活性一級アミンを酸性条件下、脱水縮合することによって得られる光学活性イミンを不斉還元することにより、光学活性二級アミンに変換し、該二級アミンを加水分解することにより、光学活性  $\alpha$ -メチルビス-3,5-(トリフルオロメチル)ベンジルアミンを高い不斉純度で収率良く製造する。

【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号 [000002200]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 山口県宇部市大字沖宇部5253番地  
氏 名 セントラル硝子株式会社